

Pressemitteilung

13.09.2019

Leibniz IHP aus Frankfurt (Oder) organisiert die internationale Halbleiterkonferenz für Wissenschaftler, Ingenieure und Experten

Die GADEST-Konferenz findet bereits zum 18. Mal statt

Frankfurt (Oder). Vom 22. bis 27. September findet in Zeuthen (Brandenburg) die 18. Konferenz zum Thema Gettering und Defect Engineering in der Halbleitertechnologie (GADEST) statt, die vom IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik organisiert wird. Die GADEST-Konferenzreihe bietet ein Forum für die Interaktion zwischen Wissenschaftlern und Ingenieuren auf dem Gebiet der Halbleiterdefektphysik, der Materialwissenschaften und der Bauelementetechnologie. „Die Konferenz konzentriert sich auf grundlegende Aspekte sowie auf technologische Probleme im Zusammenhang mit Defekten an elektronischen Materialien und Geräten von der Mikroelektronik bis zu Photovoltaik“, erklärt Dr. Gudrun Kissinger, Konferenzleiterin und Wissenschaftlerin am IHP. Für die GADEST 2019 haben sich rund 120 Teilnehmer aus 24 Ländern angemeldet.

Die Konferenzthemen umfassen drei Hauptkategorien: Zum einen die Optimierung von Silizium (Si) als Trägermaterial für eine verbesserte Funktion elektronischer und photovoltaischer Geräte. Die zweite Kategorie umfasst Systementwürfe mit anderen Trägermaterialien als Silizium, um verbesserte und neue Funktionalitäten der Bauelemente zu erzielen. Die dritte Kategorie beschäftigt sich mit der Grundlagenforschung zu elektronischen Bauelementen sowie auftretenden Defekten und Effekten.

Die GADEST-Konferenz findet seit 1985 alle zwei Jahre statt. Bis 1995 wurde die Konferenz in Deutschland abgehalten, anschließend in verschiedenen europäischen Ländern. Die diesjährige GADEST wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und mehreren internationalen Unternehmen und Organisationen unterstützt.

Lokaler Partner der diesjährigen Konferenz ist die Investor Center Ostbrandenburg GmbH (ICOB), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder). „Unser gemeinsames Ziel ist es, das internationale Publikum auf die Chancen aufmerksam zu machen, die sich aus potenziellen Investitions- oder Kooperationsprojekten in der Region ergeben“, beschreibt Christopher Nüßlein, Geschäftsführer des ICOB, die Vorbereitungen auf die anstehende Konferenz.



innovations
for high
performance
microelectronics



Pressemitteilung



innovations
for high
performance

microelectronics



Blick in das Molekularstrahlepitaxie-Labor des IHP. Die Molekularstrahlepitaxie (englisch molecular beam epitaxy, MBE) ist ein Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung, um kristalline dünne Schichten (bzw. Schichtsysteme) herzustellen. Es findet zum Beispiel Anwendung in der Nanotechnologie. © IHP/Mausolf 2019

Weitere Informationen:

Konferenzwebsite: <https://www.gadest2019.org/index.php>

ICOB: <http://www.icob.de>

Ansprechpartner:

Anne-Kristin Jentsch

Public Relations

IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics/

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 207

E-Mail: jentsch@ihp-microelectronics.com

Website: www.ihp-microelectronics.com

Über das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP beschäftigt ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über eine Pilotlinie für technologische Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25 µm-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1000 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet.

www.ihp-microelectronics.com

